Hall - Effect 
$$E_{y} = B \cdot H_{H} \cdot J_{x}$$
;  $H_{H} = -\frac{1}{uc}$  On and  $C_{H} \cdot I_{c} \cdot I_{c}$  Bloch - Theorem  $V_{H} \cdot K \cdot (\vec{r}) = e^{i \vec{k} \cdot \vec{r}} \cdot U_{H} \cdot (\vec{r})$  ( $= U_{H} \cdot K \cdot (\vec{r}) \cdot I_{c} \cdot I_{c} \cdot I_{c} \cdot I_{c}$ )

Haupf gluch ung  $\left(\frac{h \cdot k^{2}}{2m} - E\right) \cdot C_{E} \cdot K \cdot (\vec{r} + \vec{k}) \cdot I_{c} \cdot I_{$ 

Every ie eig en werte  $20 \ \vec{k}$ :  $E_{1\vec{k}} = E_{2\vec{k}} = E_{3\vec{k}} = ...$   $E_{n\vec{k}}$ 

Eigen funktionen zu lc: Yuk (=) = Z cuk-G

periodisanc Randb.

 $\vec{k}_{i} = \sum_{i=1}^{3} \frac{m_{i}}{N_{i}} \vec{b}_{i}$ 

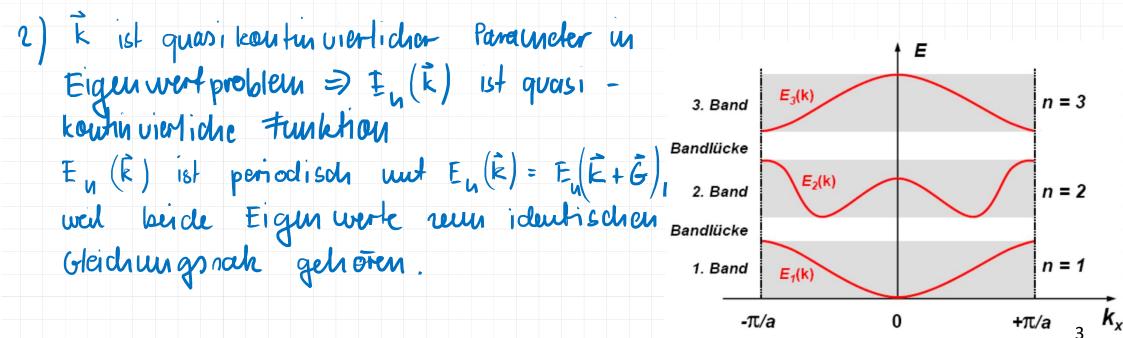
m; € 72

Schlußlolgerungen aus Bloch-Theorem

1.) Fran Elektronenger: tik = p , Y; TVT e iki p Y = ti DY; = tik Y k

Bloch wellen:  $\Psi_{nk} = U_{nk} e^{ik\hat{r}}$   $\hat{P} \Psi_{nk} = \frac{t_n}{l} P \Psi_{nk} (\hat{r}) = t_n \hat{k} \Psi_{nk} (\hat{r}) + \frac{t_n}{l} P U_{nk} (\hat{r}) + const \Psi_{nk} (\hat{r})$   $t_n \hat{k}$  ist kein Eigenwert des lunpuls operators.  $t_n \hat{k}$  ist konstallunpuls

Wegen des korden Translationssymmetrie ist tik nur bis auf  $\hat{G}$  erhalten.



Da  $F_u(\vec{k})$  pernoelisch und (quasi) stehg Die Eigenwerte  $F_u(\vec{k})$  heißen Band unt Bandunder u Bander konnen überlappen oder durck Luden gebrennt sein Dic Band-dispersion outscheidet über du delbonischen Figurschaften des Fks. 3.) Analog un den Phononen, wo Vpho = DR w(k) (vpho = dw 10) ist  $\vec{v}_n(\vec{k}) = \frac{1}{t_1} \nabla_k E_n(\vec{k})$  die gruppengischwindigent dr Blochelelhouen, brev eines Wellen partits aus Enstanden um  $F_n(\hat{k})$ .
Blochelelhouen sheven uncht au vouenrampfen. 8.2 Notelle, Halls metalle, Halls later und Isolatoren Die Huzald der R-Velloren in 1 BZ ist N (N = # Eleinterzellen) nit

2 Spur sustanden pro Band hat judes Band 2 N Zustande bew. le pro Elementar. zelle Beadre: Energie eigen werte und dannit Bander konnen entartet sein. Fall 1: Einige Bander sund vollstandig Leitungsband 🚃 gefüllt, andere Bänder sund vollständig ber Leitungsband Leitungsband bei T = 0. Not wendige Bedingung Valenzband Valenzband ur dusen Fall 1st eine glade Metall Halbmetall Isolator oder Halbleiter Auzald von Valeuz delloum. Ist du Energulude Fg >>> kBT so handelt es sich um einen Isolator (on O alle T), est Eg » k<sub>B</sub>T so dass e vour <u>Valenz bound</u> uns <u>Leitungsbound</u> unterhall der Schmelz teur perateur T<sub>m</sub> augeregt werelln leonnen, so handelt es sich um einen Halbleiter Ex liegt im Bereich verbotener zustände,

zwischen den Bandern. Eure außere Kreft  $t_i \hat{k} = \hat{T}_i$  du du Bandstruktur und  $t_i \hat{k} = \hat{T}_i$  du du Bandstruktur und  $t_i \hat{k} = \hat{T}_i$  du du Bandstruktur und  $t_i \hat{k} = \hat{T}_i$  du du Bandstruktur und keine  $t_i = \hat{t}_i = \hat{t}_i$  du du Bandstruktur und keine  $t_i = \hat{t}_i = \hat{t}_i$  du du Bandstruktur und keine  $t_i = \hat{t}_i = \hat{t}_i$  du du Bandstruktur und keine  $t_i = \hat{t}_i = \hat{t}_i$  du du Bandstruktur und keine  $t_i = \hat{t}_i = \hat{t}_i$  du du Bandstruktur und keine  $t_i = \hat{t}_i = \hat{t}_i$  du du Bandstruktur und keine  $t_i = \hat{t}_i = \hat{t}_i$  du du Bandstruktur und keine  $t_i = \hat{t}_i = \hat{t}_i$  du du Bandstruktur und keine  $t_i = \hat{t}_i = \hat{t}_i$  du du Bandstruktur und keine  $t_i = \hat{t}_i = \hat{t}_i$  du du Bandstruktur und keine  $t_i = \hat{t}_i = \hat{t}_i$  du du Bandstruktur und keine  $t_i = \hat{t}_i = \hat{t}_i$  du du Bandstruktur und keine  $t_i = \hat{t}_i = \hat{t}_i = \hat{t}_i$  du du Bandstruktur und keine  $t_i = \hat{t}_i = \hat{t}_i = \hat{t}_i$  du du Bandstruktur und keine  $t_i = \hat{t}_i = \hat{t}_i = \hat{t}_i$  du du Bandstruktur und keine  $t_i = \hat{t}_i =$ 

2) Die Fermi en englie liegt un nerhalb ownes Bandes, dass uicht voll steundig gefüllt ist (Leitungsband). Wie beim freien e-Gas ist du Fläche E= E; du Fermi fläche, du aber nicht mehr un bedmigt eine Kugul oberfläche ist Dwirt owne äußere Knaft tik = F können e- un un besehle Zustande Oberhalb E; beschleu nigt werelln Daraus folgt du elektrische Leitfähig keit.

Bei Bandiberlappung unt wenig fehlenden et un Vallnzband und wenig et un Leitungsband (unsgesamt wenig freie Cadungsträger), ist die Leitfähigfut gering und man spricht von einem Halbmetall

- · Die Alkalimetalle mit 1 Valenz-e sund Metalle.
  - Die Endalkali metalle kounten Isolatoren sein, benkon aber Bandüberlappung und sind aher schlechte Metalle
- · Diamant, Si, Ge besiten 2 x 4 Valurz electronen pro Embetszelle.

  Die 4 voll besetzten Valurz bander überlappen nicht unt dem

  Leitungsband => Diamant ist Iso later, Si, Ge sund Halbleiter

## 8.3 Zouen Schemata

Als sur ples Beispiel behandeln wir du Dispersionsvelationen von Bloch-e- für den Crenz pell U->0, d.h. preie e

1) 
$$10 - Fall \cdot G = \frac{2l}{\alpha} \cdot m = g \cdot m \cdot m \in \mathbb{Z}$$

Die Dispersion ist periodisch E(k) = E(k+G)

